

2026年6月期 決算説明資料

連結決算概要および業績予想
中長期経営計画進捗

株式会社 アルバック
2026年8月14日

将来見通し等に関する記述についての注意事項

■ 将来見通しについて

本資料に記載の業績見通しならびに将来予測は、現在入手可能な情報に基づき作成されたものです。世界経済情勢、半導体・電子部品・ディスプレイ・原材料などの市況、設備投資の動向、急速な技術革新への対応、為替レートの変動など様々な要因により、実際の業績・成果等はこれらの見通し・将来予測と大きく異なる可能性があることをご承知おきください。

■ 数字の処理について

本資料に記載の数字・比率につきましては、単位未満四捨五入で処理しております。

■ 品目名称変更について

2025年6月期より、FPD製造装置の名称をディスプレイ・エネルギー関連製造装置に変更しております。

1. 2026年6月期 業績概要

- 受注高: **過去最高の3,242億円を達成**、半導体・ディスプレイ・レアアース関連ビジネスが牽引
- 売上高・営業利益: 前回予想を上回る着地もEV関連の一過性費用等の計上により前期比増収減益

2. 2027年6月期 業績予想

- 受注高・売上高: 事業改革による剥落、ディスプレイ関連等の反動減を織り込むも、半導体電子ビジネスは高水準を継続
- 各利益項目: 半導体・レアアース関連等の高収益案件寄与により
売上総利益率はバリューアッププラン水準(33.7%)を見込み、営業利益率も大きく改善

3. 中長期経営計画(バリューアッププラン)の進捗

事業環境変化に伴い、27/6期はバリューアッププランを「総点検・変革」し、28/6期以降の利益成長へつなげる

- 成長戦略: AI・データセンター関連ビジネスを戦略テーマとして定義、重点分野へ経営資源を集中投入
- 事業改革: 本社機能・固定費構造・事業ポートフォリオ改革を再定義
- 生産改革: 売上・利益の最大化を実現するため、部材供給・生産制約の早期解消を最優先で推進する

1

2026年6月期 業績概要

業績概要

- 受注高：過去最高の3,242億円を達成 前期比+987億円的大幅増加
- 売上高：概ね前回予想通りに着地 前期比+179億円の増収
- 各利益項目：EV関連の一過性費用等の計上により、概ね前回予想通りに着地

【単位:億円】	25/6期	26/6期					
		前回予想	通期実績	前期比		前回予想比	
受注高	2,256	3,100	3,242	+987	+44%	+142	+5%
売上高	2,512	2,600	2,691	+179	+7%	+91	+4%
売上総利益	799	770	777	-21	-3%	+7	+1%
率	31.8%	29.6%	28.9%	-2.9pt	-	-0.7pt	-
営業利益	265	190	196	-69	-26%	+6	+3%
率	10.6%	7.3%	7.3%	-3.3pt	-	-0.0pt	-
経常利益	286	190	199	-87	-30%	+9	+5%
率	11.4%	7.3%	7.4%	-4.0pt	-	+0.1pt	-
親会社株主に帰属する 当期純利益	167	185	171	+4	+2%	-14	-8%
率	6.6%	7.1%	6.4%	-0.3pt	-	-0.8pt	-
1株あたり配当金(円)	164	152	152	-12	-	±0	-

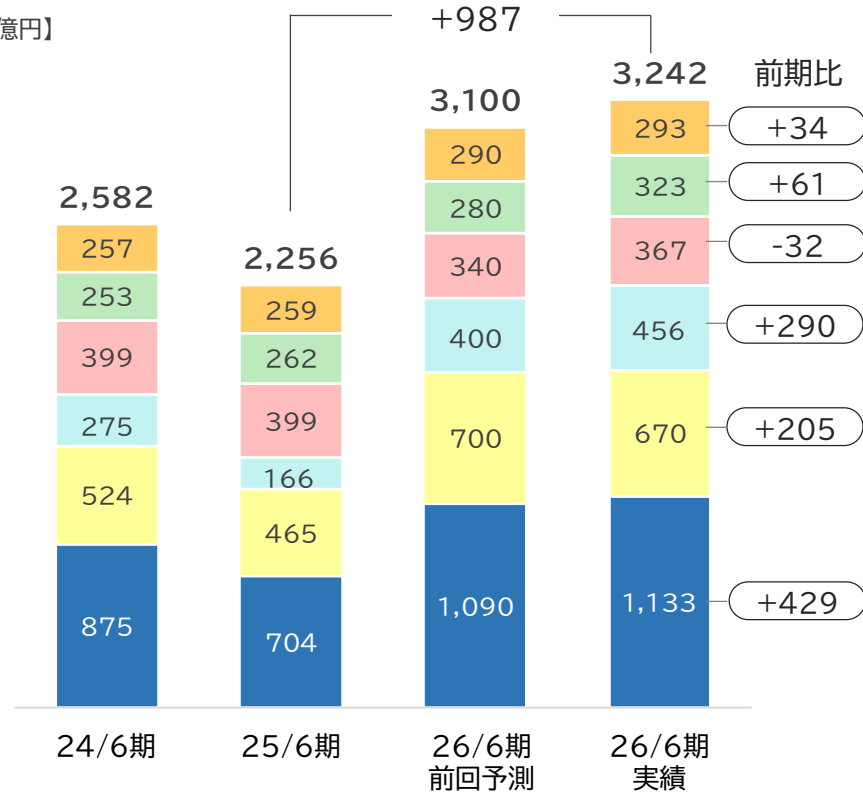
受注高・売上高実績

- 受注高: 半導体、ディスプレイ、レアアース関連ビジネス含む一般産業等が前期比大幅増加し、過去最高を達成
- 売上高: 概ね前回予想通りに着地

受注高

■ 半導体及び電子部品製造装置 ■ 一般産業用装置 ■ マテリアル
■ ディスプレイ・エネルギー関連製造装置 ■ コンポーネント ■ その他

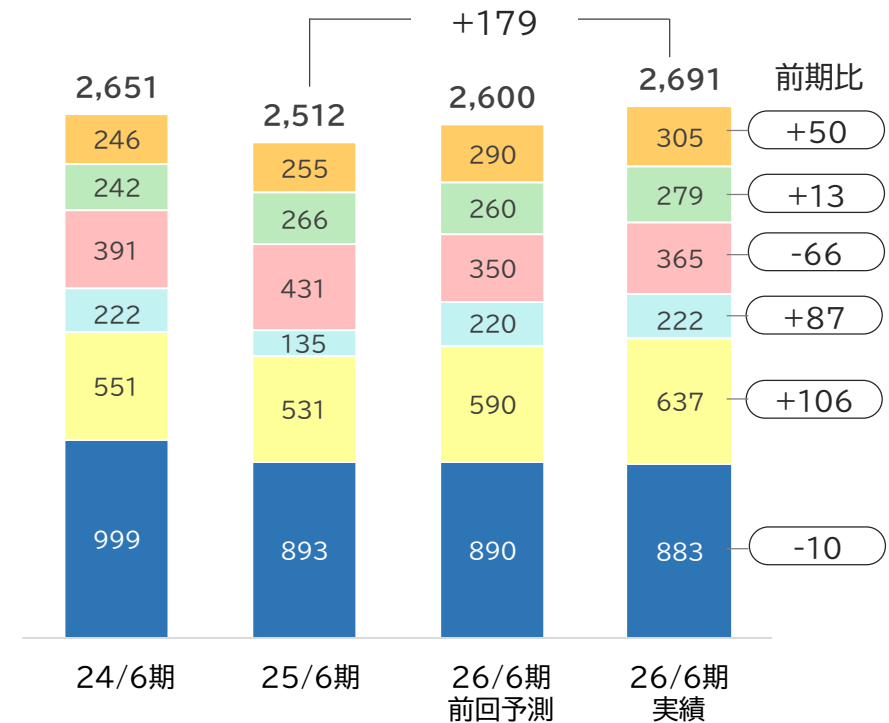
【単位: 億円】



売上高

■ 半導体及び電子部品製造装置 ■ 一般産業用装置 ■ マテリアル
■ ディスプレイ・エネルギー関連製造装置 ■ コンポーネント ■ その他

【単位: 億円】



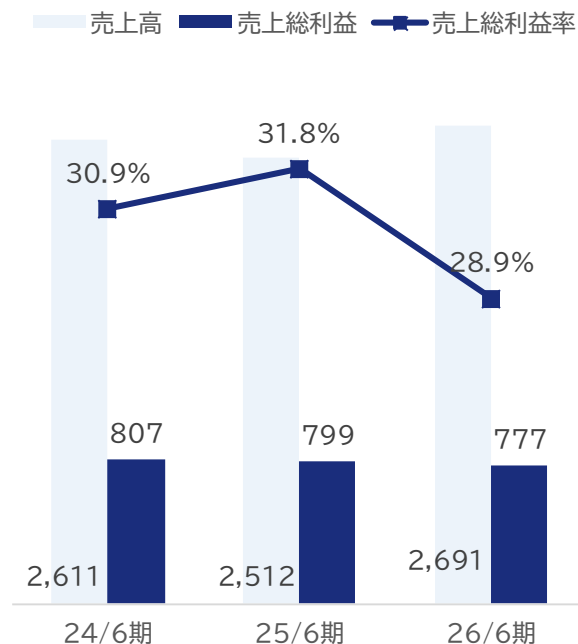
※ 26/6期より、リークテスト装置の受注高および売上高の分類を、コンポーネントから一般産業用装置へ変更

利益率推移

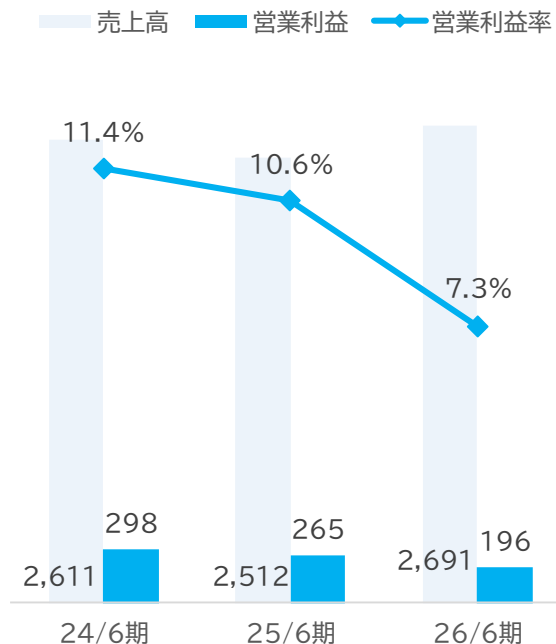
- 売上総利益率: EV関連費用計上、ディスプレイ関連ビジネス増加等によるミックス変化もあり前期比2.9pt低下
- 営業利益率: 一過性要因、研究開発費増加等による販管費増加により前期比3.3pt低下

【単位: 億円、%】

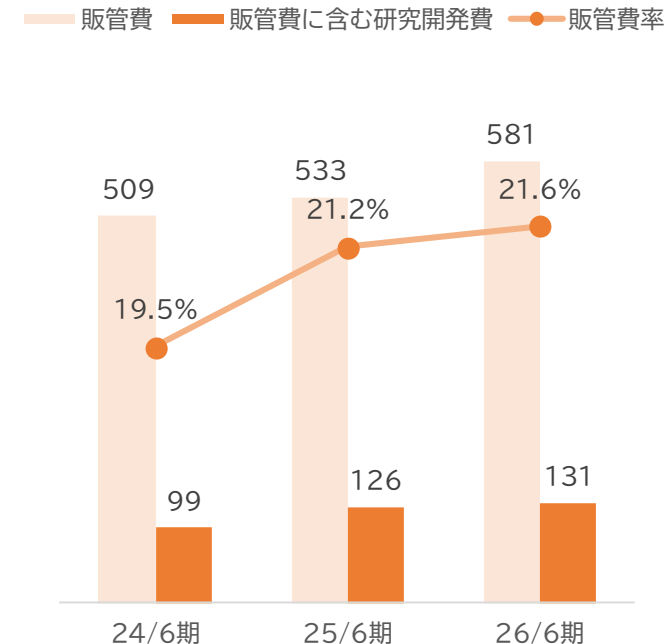
売上総利益率



営業利益率



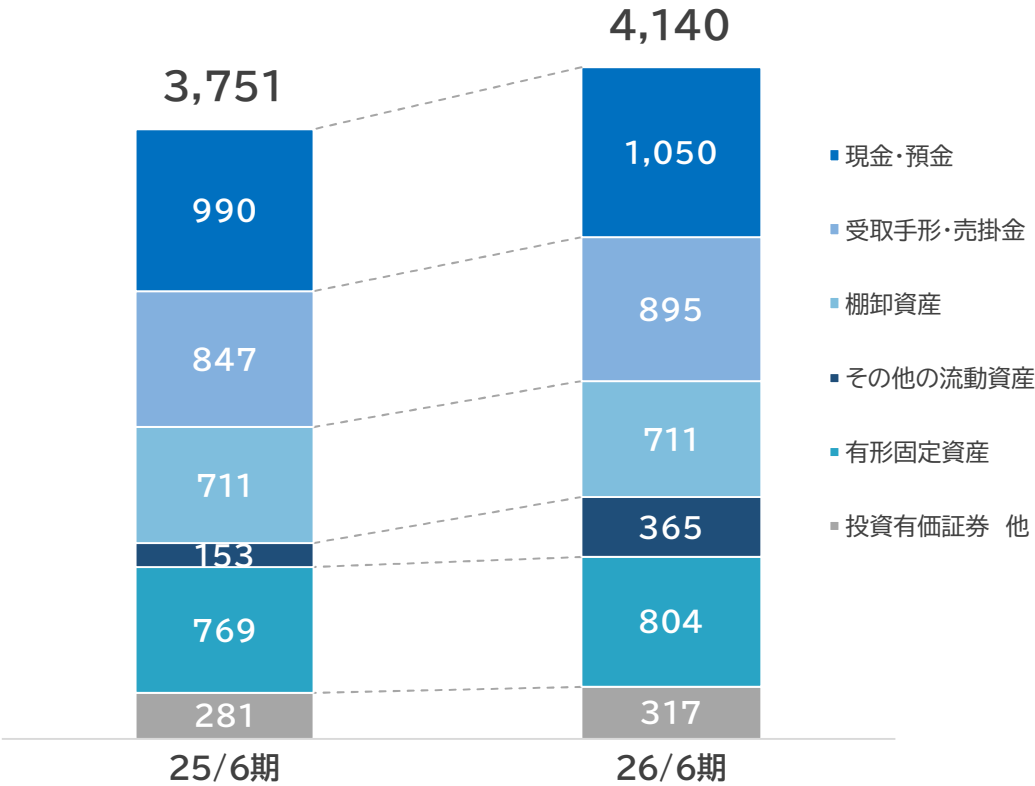
販管費率



貸借対照表

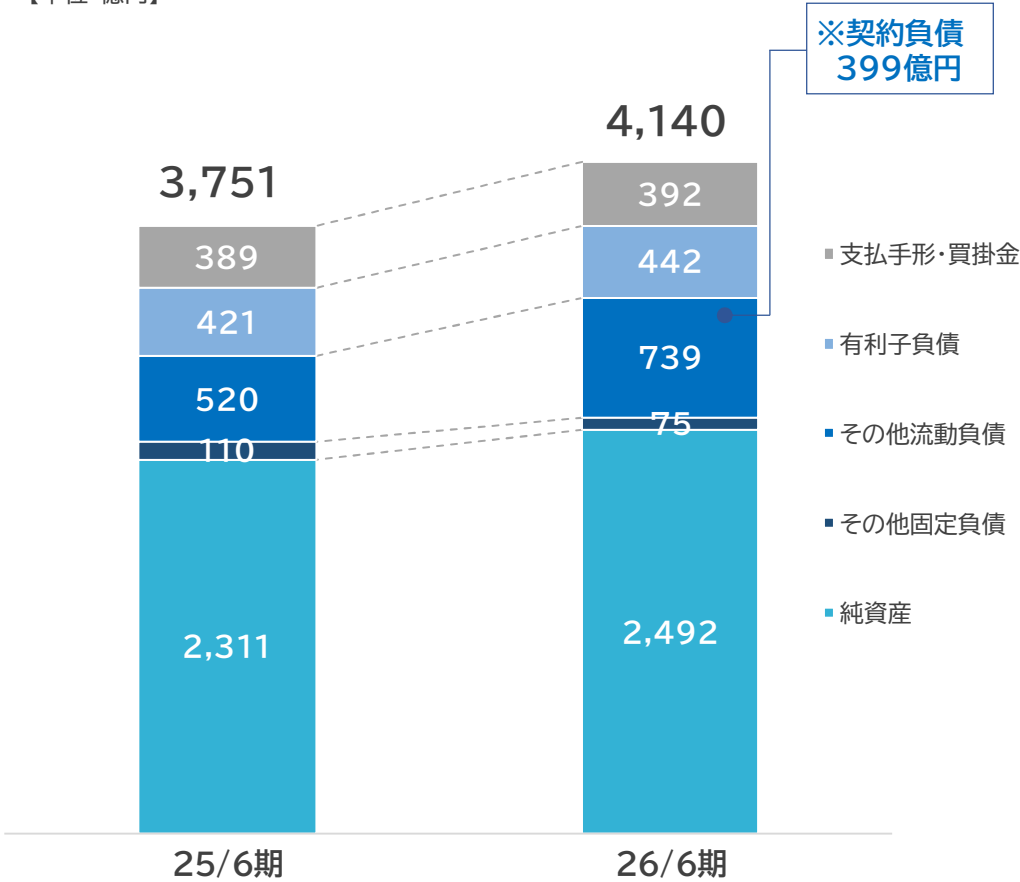
資産

【単位:億円】



負債・純資産

【単位:億円】



2

2027年6月期 業績予想

- 受注高・売上高：事業改革による剥落、ディスプレイ関連の反動減を織り込むも、半導体ビジネスは高水準継続
- 各利益項目：高収益案件の寄与により**売上総利益率33.7%**(前期比+4.9pt)、営業利益率も大幅改善を計画
- 株主還元：安定的な還元の観点から前期据え置きの152円

【単位:億円】	26/6期	27/6期 計画				
		上期	下期	通期	前期比	
受注高	3,242	1,300	1,300	2,600	-642	-20%
売上高	2,691	1,250	1,300	2,550	-142	-5%
売上総利益	777	415	445	860	+83	+11%
率	28.9%	33.2%	34.2%	33.7%	+4.9pt	-
営業利益	196	125	155	280	+84	+43%
率	7.3%	10.0%	11.9%	11.0%	+3.7pt	-
経常利益	199	125	155	280	+81	+41%
率	7.4%	10.0%	11.9%	11.0%	+3.6pt	-
親会社株主に帰属する 当期純利益	171	80	110	190	+19	+11%
率	6.4%	6.4%	8.5%	7.5%	+1.1pt	-
1株あたり配当金(円)	152			152	±0	

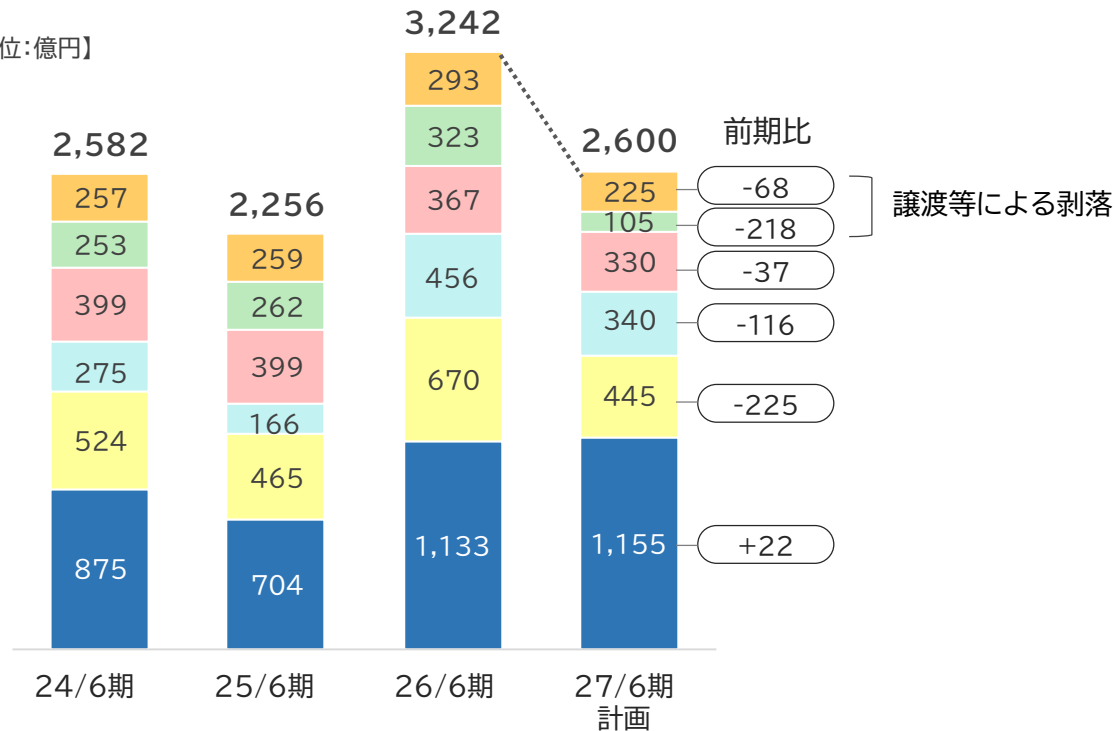
受注高・売上高計画

- 受注高:事業改革による剥落、ディスプレイ関連の反動減により全体受注は減少も、半導体電子ビジネスは高水準継続
- 売上高:事業改革による剥落と装置L/T長期化による次期(28/6期)への売上シフトが生じる一方、高利益率案件(半導体・レアアース関連)の売上構成比は着実に向上

受注高



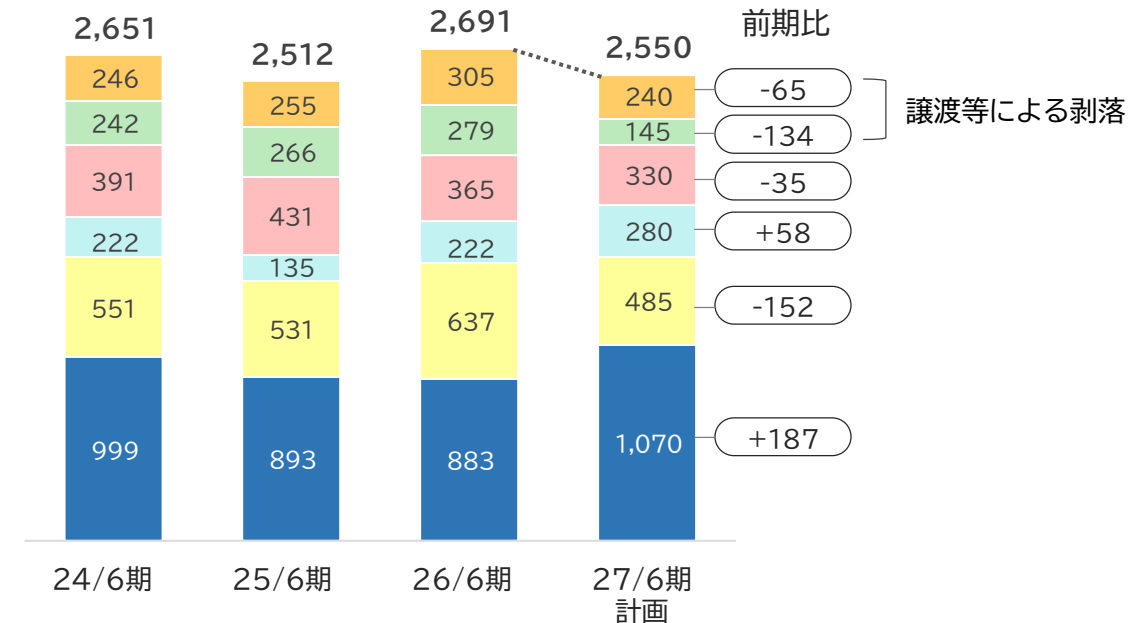
【単位:億円】



売上高

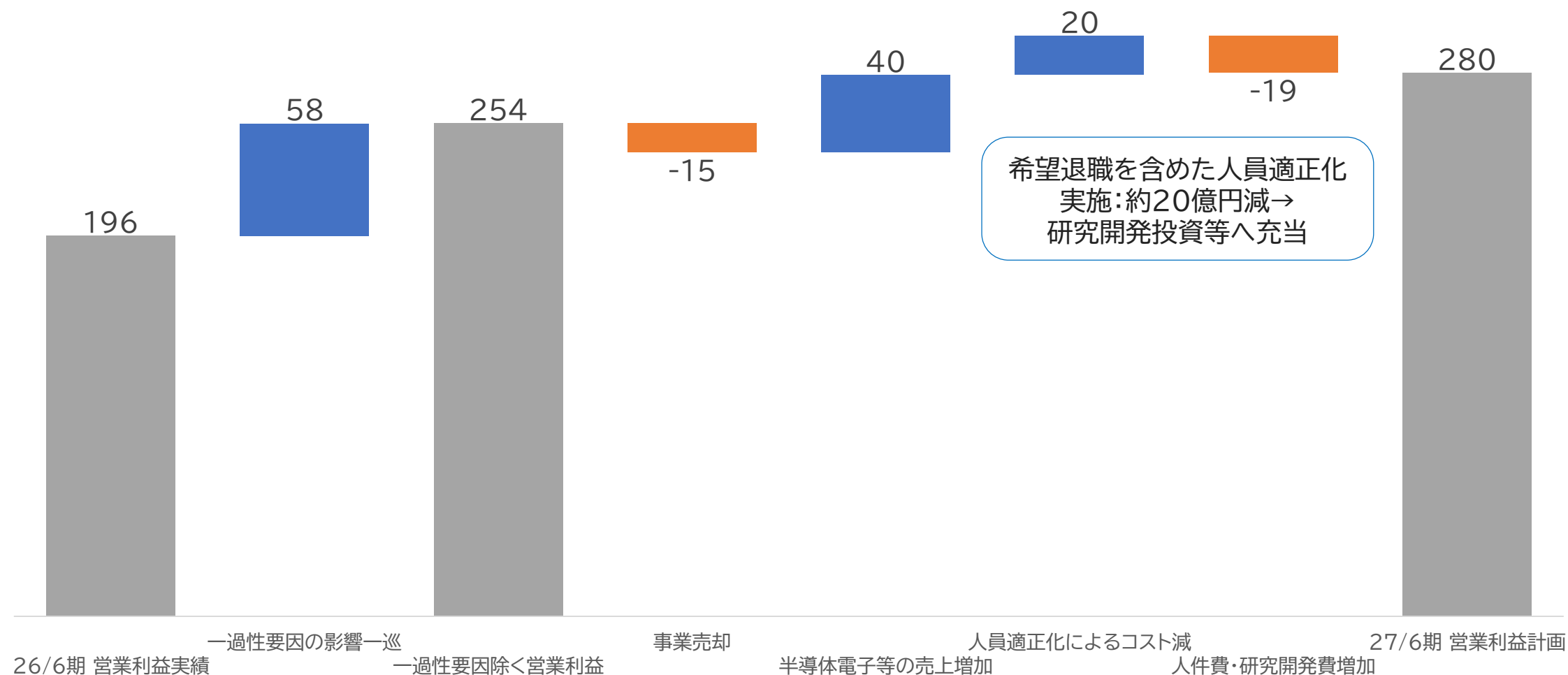


【単位:億円】



※ 26/6期より、リークテスト装置の受注高および売上高の分類をコンポーネントから一般産業用装置へ変更

- 事業売却による営業利益の一部剥落を、一過性要因の影響一巡・高収益な半導体電子・レアアース関連ビジネス等の利益貢献、事業改革効果により確実な成長への布石が整う

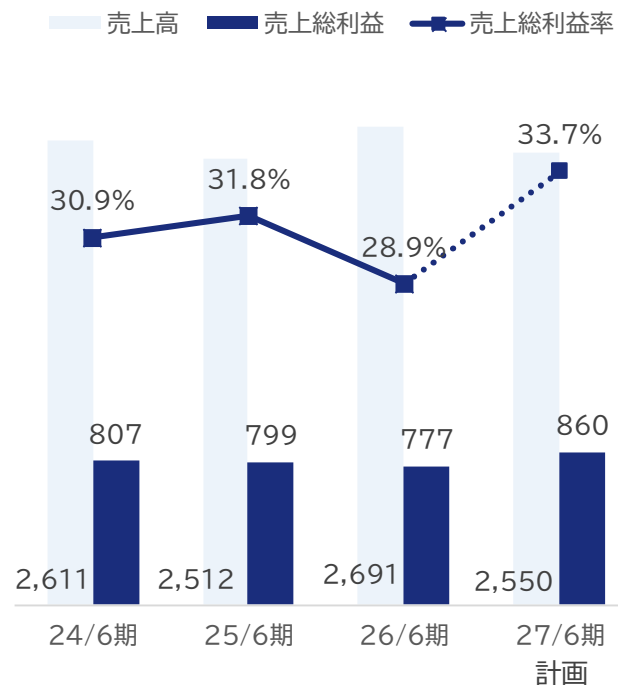


利益率計画

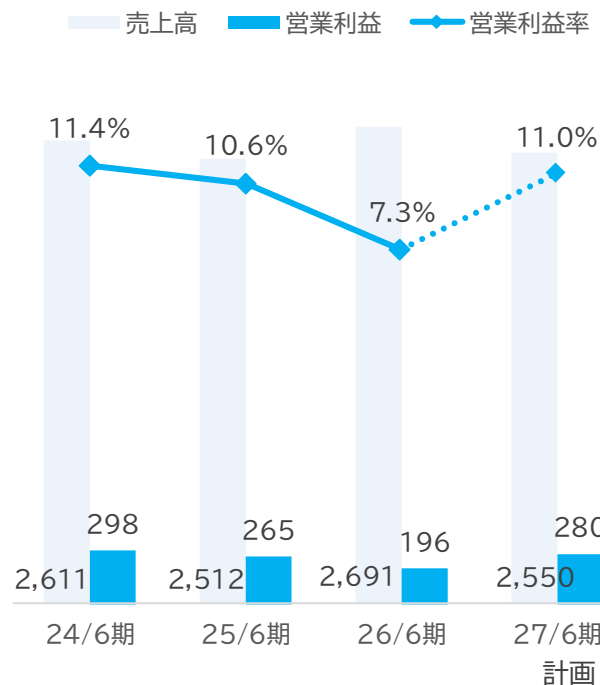
- 売上総利益率:半導体・レアアース関連ビジネスの牽引により**33.7%**(前期比+4.9pt)と大幅向上
バリューアッププラン実現に向けたステップを順調に踏む
- 営業利益率:売上総利益率改善、研究開発投資継続により**11.0%**(前期比+3.7pt)

【単位:億円、%】

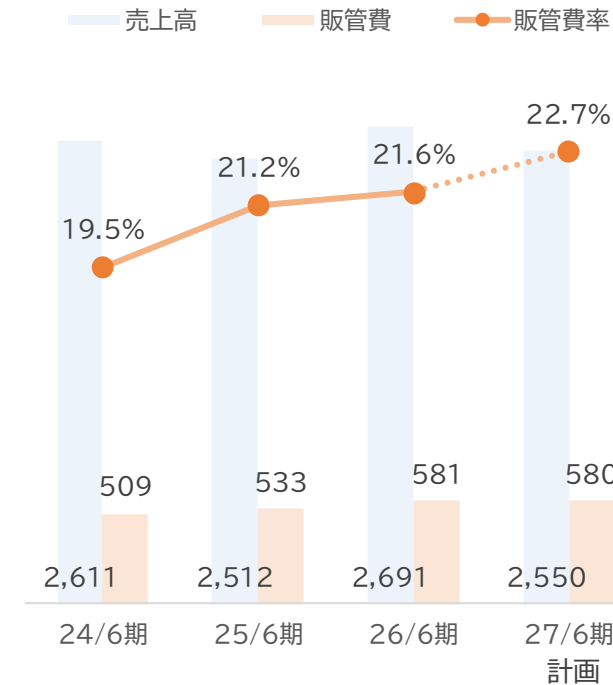
売上総利益率



営業利益率



販管費率



3

バリューアッププランの進捗

25/8策定時からの外部環境変化

フィジカルAIの市場成長期待も、足元ではAI・データセンター関連ビジネスが急速に拡大



バリューアッププラン具現化のために

AI・データセンター関連ビジネスにおける確かな遂行能力と実績を基盤に、全方位で市場を捉え、戦略的に成長を実現

初年度の成果

成長戦略

- ・ 受注高3,242億円、過去最高を達成
- ・ 半導体は市場を大きくアウトパフォーム

事業改革

- ・ ディスプレイ関連事業・低採算事業整理
- ・ 生産拠点再編

生産改革

- ・ モジュラーデザイン推進
- ・ 設計工数20%削減／変動費10億円圧縮



課題

業績面

- ・ 受注高の成長に対し、売上高・営業利益の成長が限定的に

生産面

- ・ 部材供給リスクが顕在化
— サプライチェーン上の制約が表面化
- ・ 製造L/T(リードタイム)の短縮は道半ば
— 生産能力に制約

受注を確実な売上・利益成長へ転換できていないことが、収益性向上に向けた明確な課題

27/6期「総点検・変革」から、28/6期以降の「成長実現」へ

- 事業環境の変化に伴い、これまでの取り組みを総点検したうえで必要な変革を断行し、28/6期以降の急成長への基盤を確立する重要な一年

成長戦略

戦略テーマ
**AI・データセンター
関連ビジネス**

- 自社の強みを見極め、重点分野へ経営資源を集中投入
- 先端・高付加価値案件の構成比上昇により、高成長・高収益性を実現

事業改革

経営資源の最適化に向けた事業ポートフォリオの抜本的な再点検を進め、追加施策を機動的に検討していく方針

● 現計画完遂

- 26/6期:4社を非連結化 27/6期:残り4社の非連結化実行
- 26/6期:東北工場再構築完了 27/6期:韓国工場再構築を実施

● 追加施策

戦略適合性の低い事業の売却・縮小を追加検討方針

● 固定費削減

希望退職を含めた人員適正化実施:約20億円減→研究開発投資へ充当
本社機能・固定費構造・事業ポートフォリオ改革を再定義

生産改革

課題:部材供給・生産制約で、受注を売上・利益成長へ転換できていない

生産体制全体を抜本的に見直す

調達
強化

+

物流
効率化

+

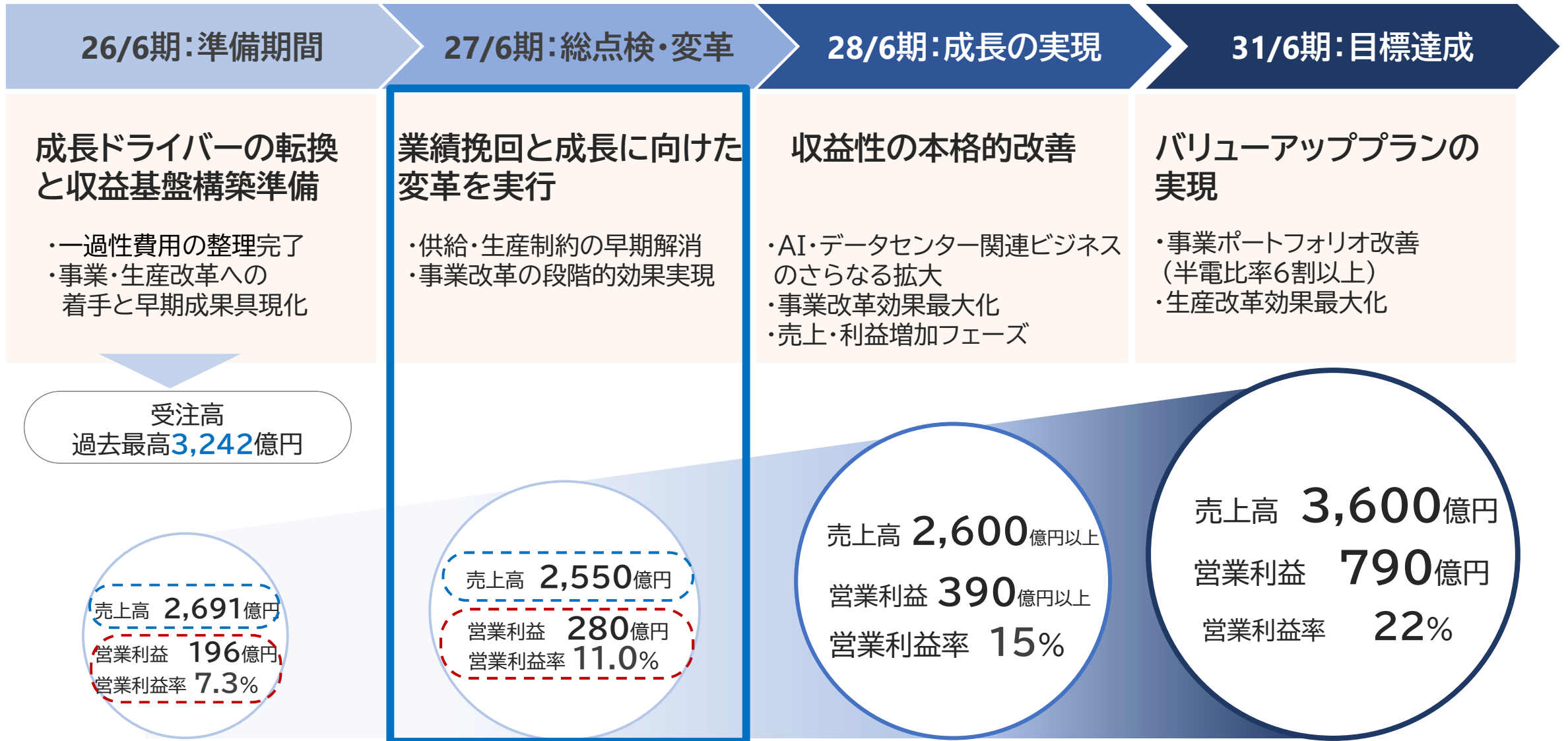
生産
UP

事業改革との連動で生産・物流拠点最適化を図り、装置L/T短縮・キャパUPを図る

受注を確実な売上・利益成長へ転換 ▶ 28/6期以降の成長へつなげる

次期(28/6期)の本格成長に向け、新体制で確実な「実行」へ

- 27/6期は成長阻害要因の抜本的見直しを図り、28/6期以降の利益成長へつなげる

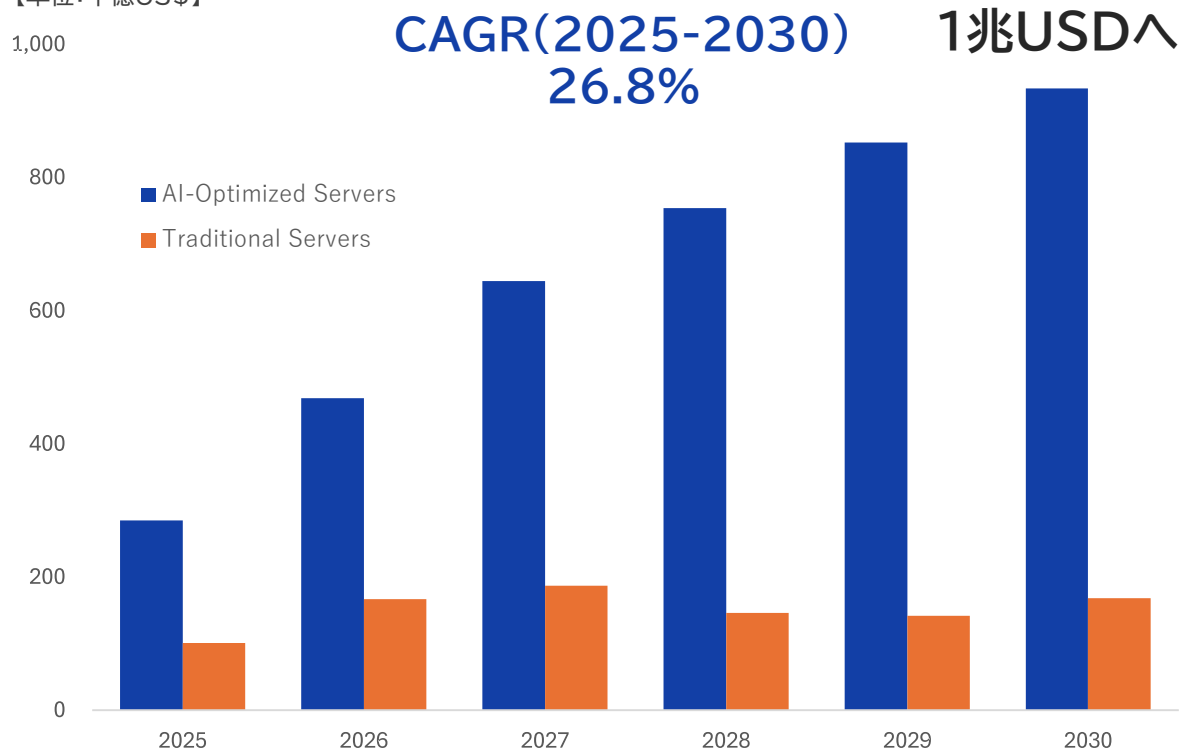


成長戦略: AI・データセンター市場を戦略テーマとして定義

- AI・データセンター市場の急速な拡大を成長機会と位置付け、重点的に事業展開を推し進める

AIデータサーバー投資推移

【単位:十億US\$】



Source: Gartner

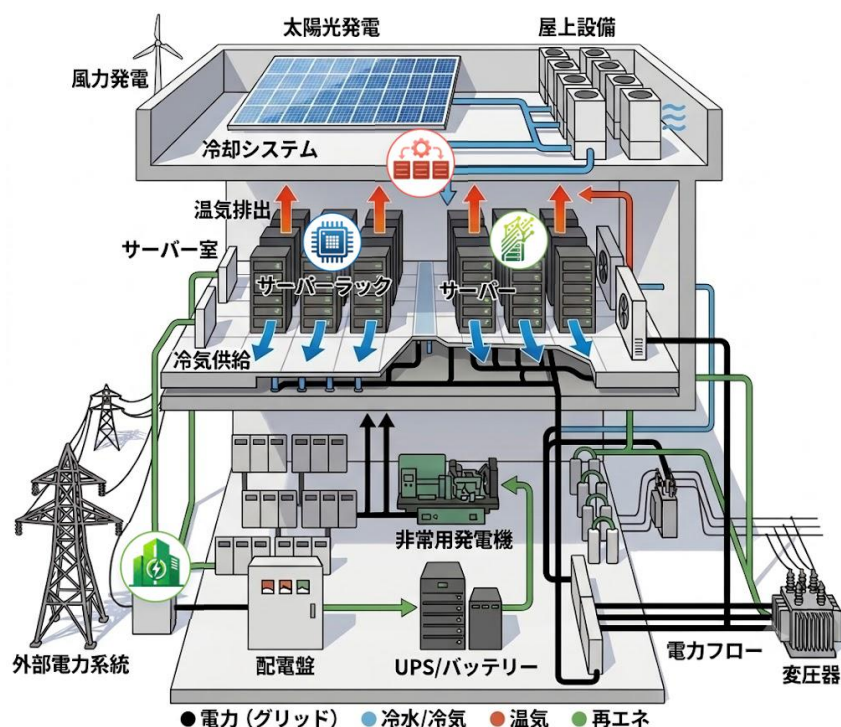
世界の投資がAI・データセンターに集中



成長戦略: AI・データセンターの主要領域を全方位で獲得

- AI・データセンターの主要領域における豊富なビジネス実績と確かな遂行能力を既に有する。この圧倒的な強みを最大限に活かした全方位での市場獲得と戦略的かつ力強い成長を実現

データセンター内部図イメージ



AI・データセンターを構成する主要領域



半導体製造

GPU/CPU
ストレージ

ロジック
DRAM・NAND
先端パッケージング、マテリアル
HDD用モーター(レアアース磁石)
デバイス分析・検査



データ通信

通信デバイス(光デバイス等)



給電・配電システム

パワーデバイス
フィルムコンデンサー
発電・送電・蓄電システム
超電導ケーブル



インフラ設備

強制液冷パネル
各種ポンプ
チラーモーター(レアアース磁石)

成長戦略：中心となる成長エンジン

- 半導体(ロジック・メモリ)と先端パッケージングに加え、レアアース磁石関連も成長エンジンとなり、AI・データセンタービジネスの成長を力強く牽引

半導体製造

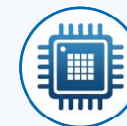


ロジック・メモリ

ハードマスク膜+金属工程膜の適用拡大に伴うソリューション提供

- コア技術「PVD」の優位性を活かし、先端ノードでの新技術開発から成熟ノードへの横展開まで、全方位でシェア拡大を図る

半導体製造



先端パッケージング

WLP+PLP向けソリューション

- FPD事業で培った大型基板対応アッシング・スパッタリング技術をPLPへ展開
- 独自の微細プラズマ技術で、ハイブリッドボンディング等の次世代ニーズを確実に取り込む

インフラ設備



レアアース磁石

需要拡大+サプライチェーン多角化によるビジネス拡大

- 米国中心としたサプライチェーン再構築(生産回帰)が加速
- 圧倒的シェアを誇る真空溶解炉・連続式焼結炉による積極的な受注獲得

成長戦略：高シェア製品×圧倒的ラインアップによる全方位獲得

- 品質至上のAI・データセンター市場において、顧客に「一気通貫」の価値を提供する、トップシェア製品を含む稀有な幅広いラインアップを有する

トップシェア

半導体製造



表面分析・検査

研究開発から半導体量産ラインまで分析・検査のソリューション提供

- 分析機器市場：**50%強**の圧倒的シェア
- 表面分析技術を応用し、半導体検査用装置を製品化(27/6期中リリース)

データ通信



通信デバイス

データ通信の高速・大容量化を支える光デバイス・光電融合技術への展開

- トップシェア顧客との強固な取引基盤**を活かし、優位性を持つ化合物成膜・加工装置の拡販で成長市場を確実に捕捉

インフラ設備



リークテスト

AIサーバーの熱課題を解決する液冷パネルの漏れ検査用途

- 高い信頼性が求められる液冷インフラにおいて**高いシェア**を有する高性能リークテスト装置で高収益ビジネスを確立

半導体製造



マテリアル

先端半導体の微細化・積層化への技術対応

- 半導体製造装置ビジネスとの連携により、顧客歩留まり向上への貢献
- 強みのある粉末冶金技術**を活かしたタングステン等の半導体用途への事業拡大

給電・配電システム



パワーデバイス

データセンターの省電力化・高効率化ニーズの確実な取り込み

- 高いシェアを有するIGBT：裏面電極形成スパッタ、SiC：イオン注入装置**で全方位展開
- GaNスパッタリング**の欧州からの展開

インフラ設備



コンポーネント

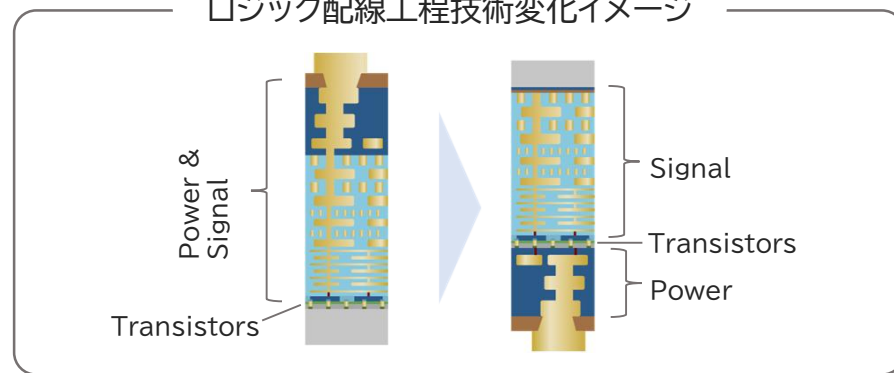
自社装置との強力なシナジー創出

- AI・データセンター関連装置(半導体・リークテスト等)の性能を支える**高信頼性ポンプ・計測・電源類**の展開
- 極低温技術**を活かし、量子コンピューター等、次世代分野への用途拡大

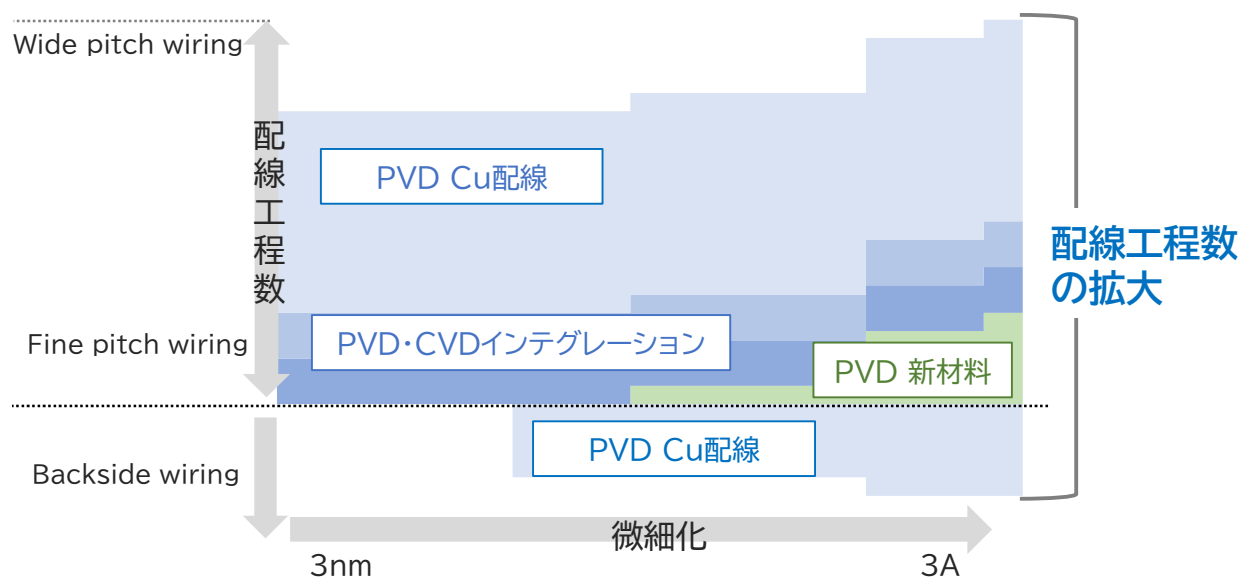
成長戦略：半導体（ロジック・メモリ）

- ・トランジスタ高密度化に伴い、ハードマスク膜の適用拡大と配線工程の増加が進展
- ・両プロセスに不可欠な当社コア技術「PVD」の重要性拡大、技術優位性を活かし持続的な高収益化を図る

ロジック配線工程技術変化イメージ



ロジック配線工程ロードマップ



ハードマスク膜の適用範囲拡大



- 27/6期～ ・成熟ノードMHM工程への横展開加速
- 28/6期～ ・アモルファスシリコンHMの適用拡大
- 29/6期～ ・ウェハ裏面給電や貼り合わせ構造におけるPVDの採用

配線工程へのアプローチ



ーメモリー

- 27/6期～ ・配線工程拡大(BEOL+RDL)

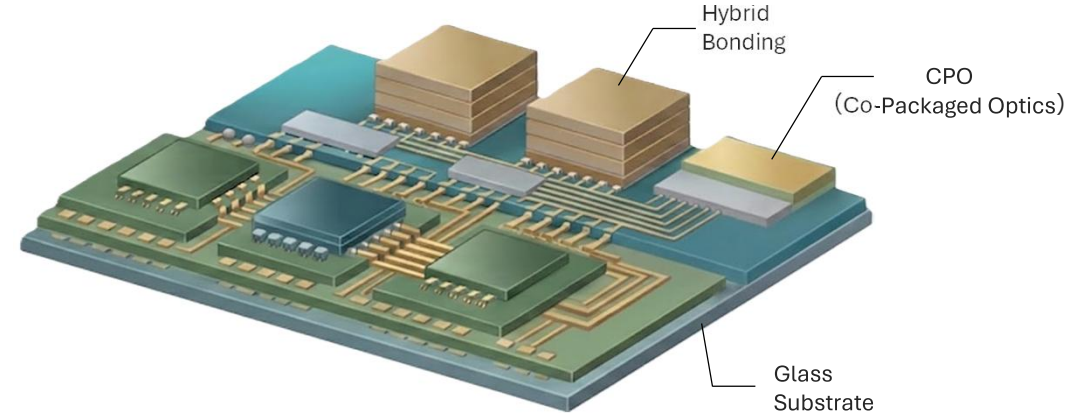
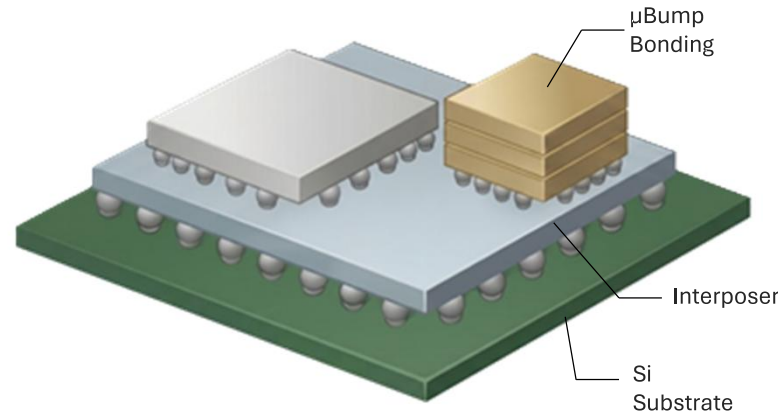
ーロジック

- 28/6期～ ・Cu配線工程のPOR獲得(Wide pitch, Backside power)
- 29/6期～ ・PVD・CVDインテグレーション技術の量産適用
・新材料(PVD)の先端開発

成長戦略：先端パッケージング

- 次世代半導体の性能を左右する「先端パッケージング技術」の高度化に伴い、当社装置の適用工程が拡大
- 半導体・電子両分野における当社の要素技術を融合し、拡大する市場で確固たるシェアを獲得する

先端パッケージング技術変化イメージ



27/6期～



微細プラズマ技術

29/6期～



ハイブリッド
ボンディング



CPO
(Co-Packaged Optics)

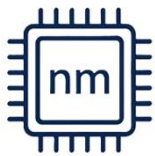


ガラス基板

電極の直接接合による配線密度の最大化
→ プラズマ技術を用いた表面活性化

超高速・低電力通信の実現
→ 化合物（薄膜ニオブ酸リチウム）の成膜・加工

基板の大型化・微細化に伴う歪みの防止
→ FPDで培ったアッシング・スパッタリング技術



システム性能向上に伴う微細化進展

- インターポザー基板の高度化：
プラズマ技術によるデスカム・デスマア工程
アッシング装置の拡大（デファクト化）



パネル成膜技術
(FPD技術応用)



搭載部品数増加に伴う基板大型化

- インターポザー基板、サブストレートのパネル化・
大型化：アッシング・スパッタリング装置の拡大

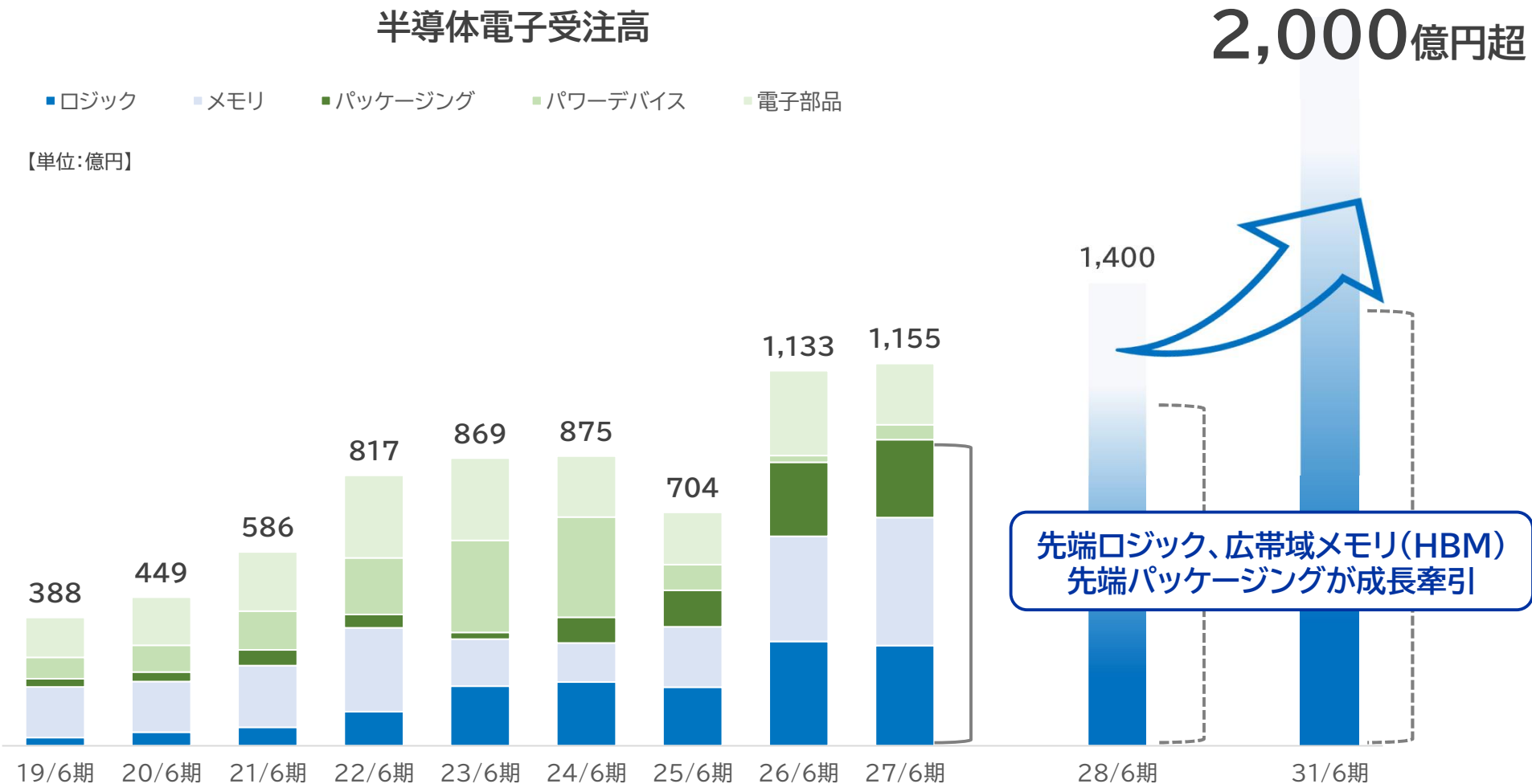
半導体電子分野：受注高2,000億円超に向けた成長軌道

- 半導体電子分野では、AI・データセンター関連の市場拡大を背景に当社装置の適用工程が拡大
- 先端・高付加価値案件の構成比上昇により、受注成長に加えて利益率の改善を牽引

半導体電子受注高

■ ロジック ■ メモリ ■ パッケージング ■ パワーデバイス ■ 電子部品

【単位：億円】



〈主力装置〉



スパッタリング装置



アッシング装置



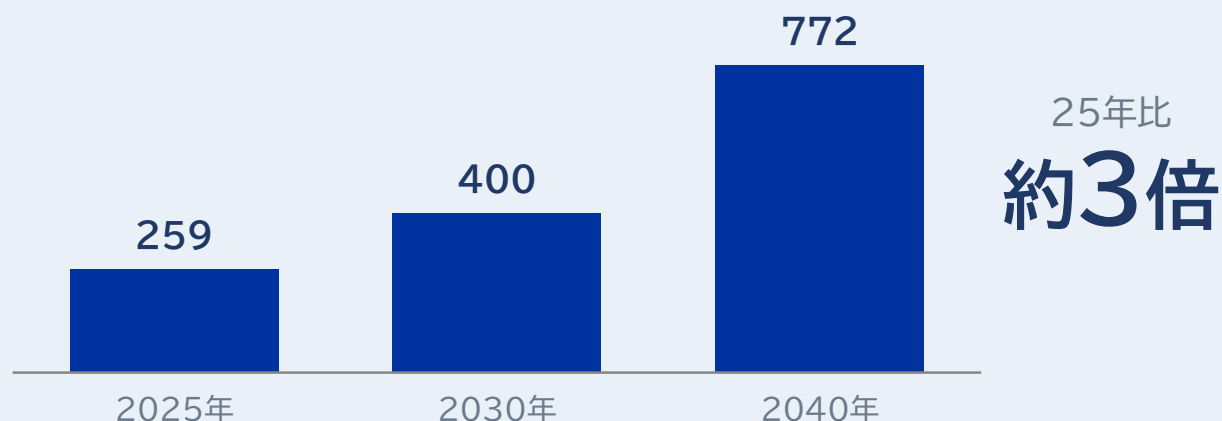
エッチング装置

成長戦略：レアアース磁石関連ビジネス

- 爆発的に拡大するAI・データセンター需要を牽引力とした、不可欠なレアアース磁石市場の急成長
「2040年に現在の約3倍」へと飛躍するネオジム磁石の巨大なグローバル需要の確実な捕捉と力強い事業拡大

市場成長

数量ベース：グローバル需要(千トン／年)



米国市場のポイント

- 米国需要はグローバルの約**18%**を占める
- 25年時点では供給を**輸入に依存**
- 30年に向け供給能力を強化し、需要の約**30%**を賄う見込みも供給は**未だ不足**

需要 — 4つの構造的ドライバー



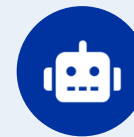
需要急増

AI・データセンター



主要用途

EVトラクションモーター



高成長

フィジカルAI



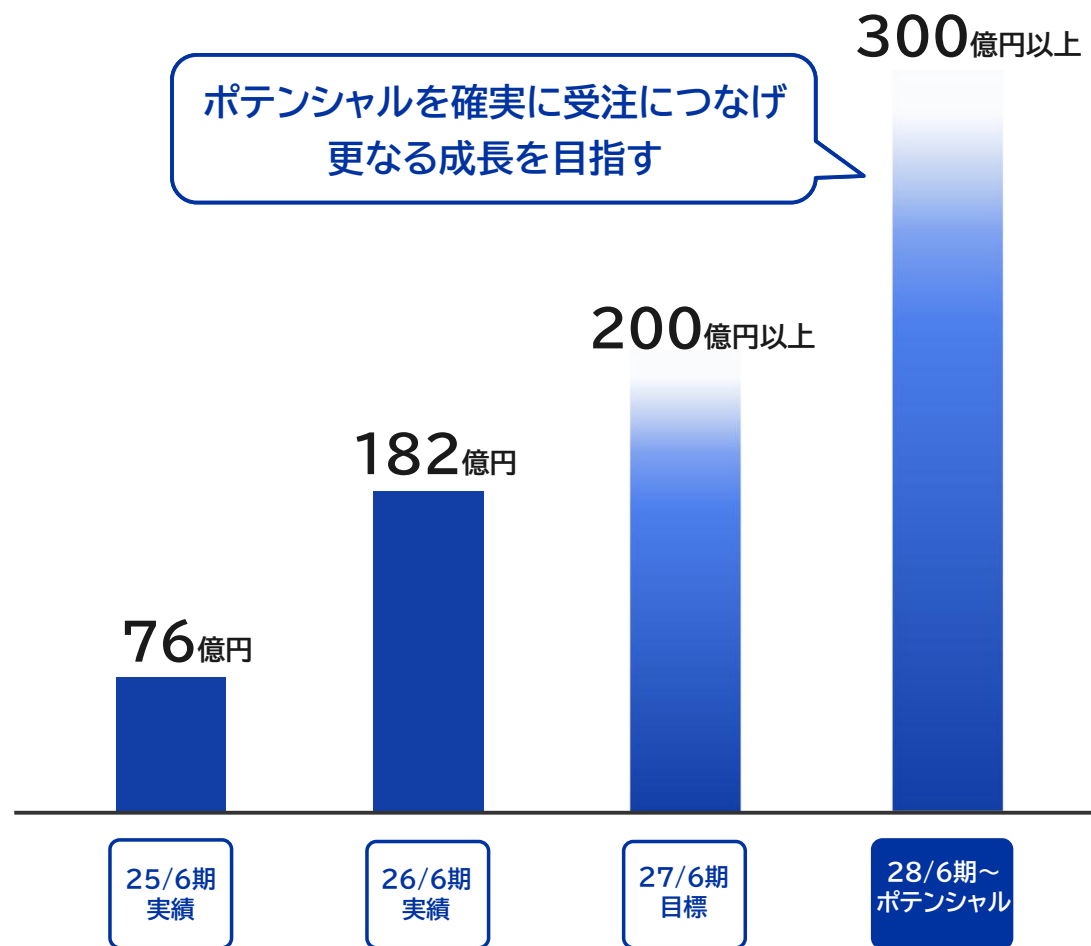
再エネ拡大

風力発電

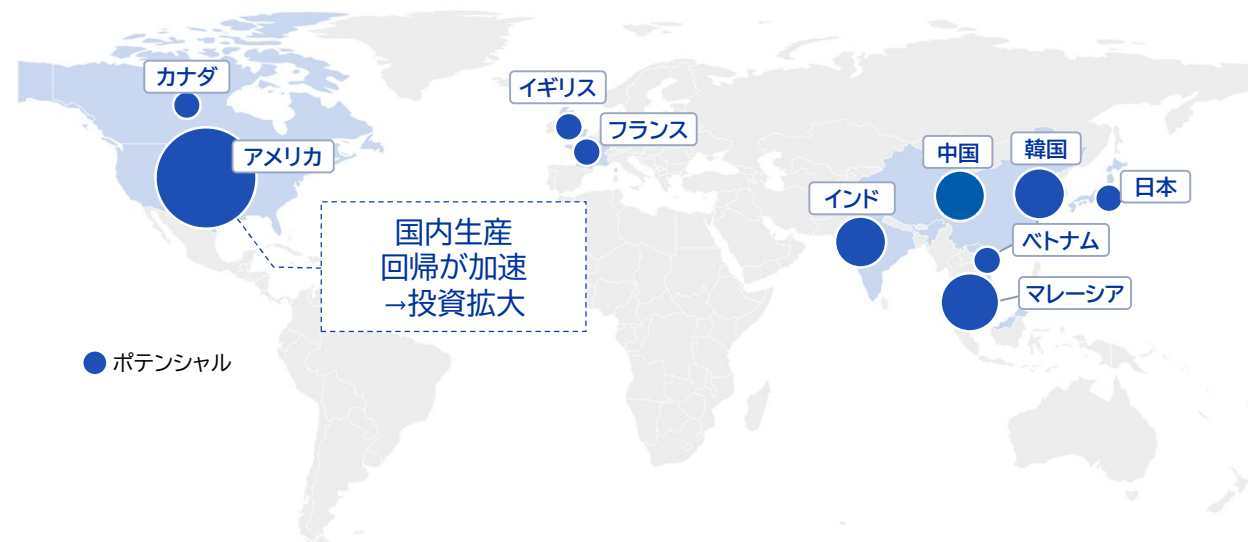
真空炉(レアアース磁石関連)受注高推移

- サプライチェーン多角化に伴う投資拡大を強力な追い風とした、高利益率案件の着実な積み上げと、確実な収益向上の実現

真空炉受注高推移



サプライチェーンの多角化



〈主力装置〉



真空誘導溶解炉



バッチ式真空炉



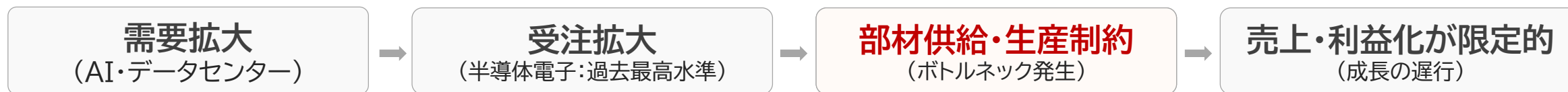
連続式真空焼結炉

- 事業売却・拠点再編等は着実に進展した一方、収益改善効果が限定的。新体制の下、本社機能・固定費構造・事業ポートフォリオ改革を再定義し、事業改革を加速する

施策	前期(26/6期)	当期(27/6期)
事業売却・縮小	- マテリアル事業譲渡(中国) - ポンプ用モーター事業譲渡 - 東南アジアCS拠点閉鎖 - 部品加工事業から一部撤退 連結子会社 非連結化 4社/8社対象	- マテリアル事業譲渡予定(韓国) - その他事業:3社譲渡予定 連結子会社 非連結化 8社/8社対象 - 本社機能・固定費構造・事業ポートフォリオを再点検
生産拠点再構築	- マテリアル関連生産撤退(日本富里工場) - 東北工場再構築 →希望退職を含む人員適正化:約20億円減 人員適正化 進捗率 4割程度	31/6期売上高:3,600億円を見据えた生産・物流拠点再編など全体最適化を再点検 - 業務効率化等による固定費削減継続

生産改革+生産・物流拠点再編による全体最適化

- 部材供給・生産制約の早期解消に向けて、生産体制全体を抜本的に見直し、売上・利益の最大化を最優先で推進
- 生産改革で目指すモジュラーデザイン比率拡大の取り組みは継続推進



27/6期の集中施策

	施策	効果
調達	サプライヤー戦略見直し・実行	部材調達L/T短縮
物流	- 各拠点の物流倉庫を集約→自動化推進による効率向上 - 物流スペースを生産スペースに転換→生産キャパシティーUP	キャパUP 生産効率UP コスト削減
生産	- 半導体電子:九州工場の増強投資検討 - レアアース関連:茅ヶ崎工場での生産開始	キャパUP 生産効率UP

27/6期中に体制整備完遂→28/6期の売上・利益向上につなげる

生産改革継続推進 (~31/6期)

設計工数圧縮L/T短縮

- 図面を変えない互換性のある設計による顧客仕様の実現

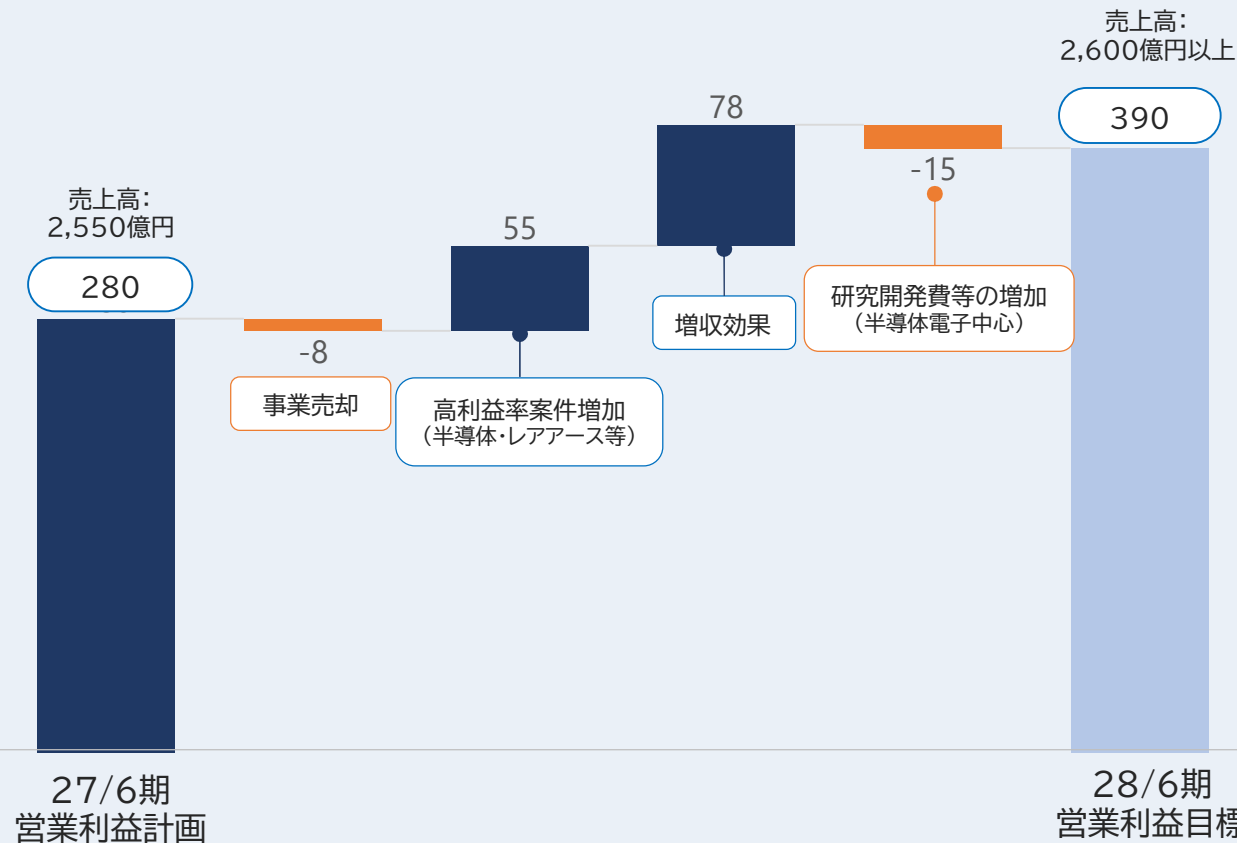
調達L/T短縮変動費圧縮

- 部品共通化と計画的まとめ発注
- 組み立て予定に合わせた部品調達

製造L/T短縮工数削減

- 標準組立と計画生産による生産ラインの最適化

28/6期に向けて 受注拡大を着実に売上・利益増加につなげる



31/6期に向けて 中長期経営計画目標の実現へ

31/6期 売上高: 3,600億円
目標 営業利益: 790億円

営業利益成長(28/6期比)

- 増収: 約320億円※
受注・売上拡大による利益額の向上
- 利益率・ミックス改善: 約140億円※
半導体電子中心の高利益率案件積上げ
- 研究開発費等の増加: ▲約60億円

※増収・利益改善
AI・データセンター向け: 約6～7割

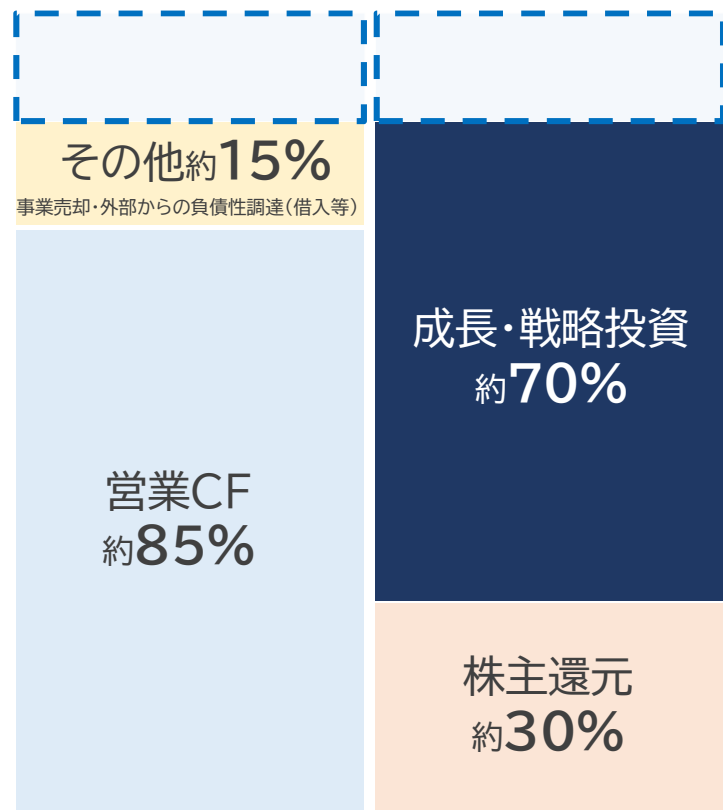
キャピタルアロケーション

- AI・データセンター領域の収益機会を最大化すべく、市場の成長スピードを凌駕する成長投資および集中的な生産拡充を実行する。さらに機動的な追加投資も視野に入れ、確実な利益成長へと繋げる

キャピタルアロケーション

(6か年累計：26/6期～31/6期)

成長機会に応じた機動的な追加投資も視野



投資領域	主な使途	計画への貢献
・ AI・データセンター 関連ビジネス (半導体電子・レアアース関連等)	研究開発、評価・デモ設備、 先端プロセス対応	市場成長を受注・利益へ転換
・ 生産・物流拠点最適化	生産能力強化、顧客案件対応、 サプライチェーン対応	成長案件の確実な獲得
・ M&A	拠点再編、在庫適正化、物流 効率化	L/T短縮・コスト削減
	技術・顧客基盤・地域補完の 獲得	中長期成長の選択肢拡大

さらなる株主還元拡充を目指す

AI・データセンター市場の成長を確実に取り込むべく、
新体制の推進力で「総点検と変革」を完遂し、
「利益拡大フェーズ」へ本格移行

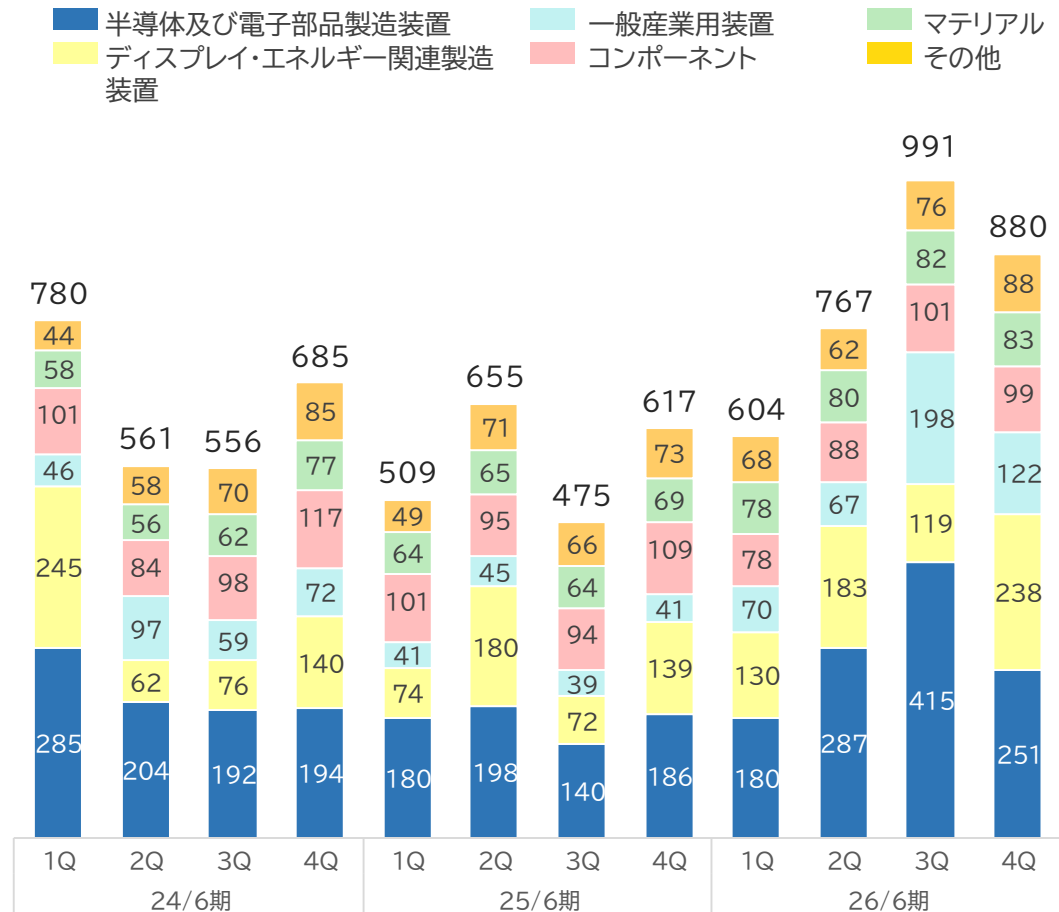
Appendix

業績(四半期推移)

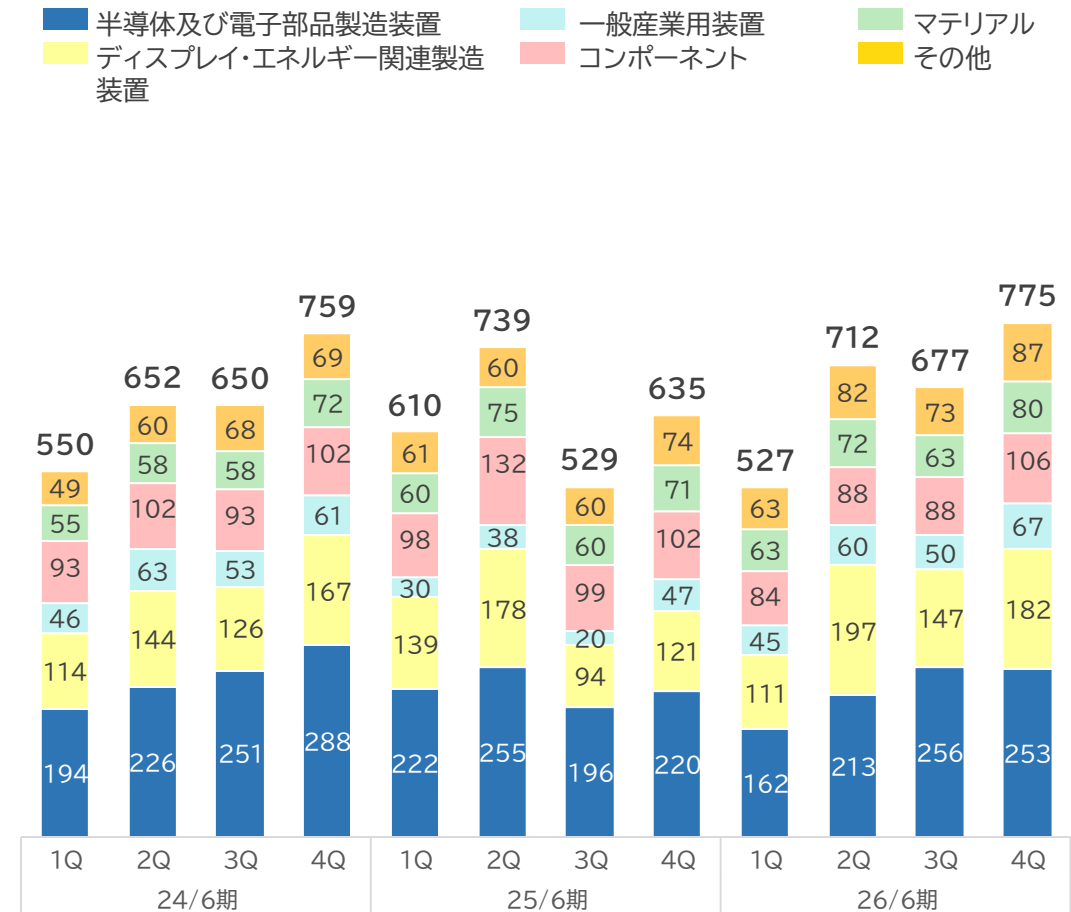
【単位:億円】	2025/6期					2026/6期						
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	前年同期比	
受注高	509	655	475	617	2,256	604	767	991	880	3,242	+987	+44%
売上高	610	739	529	635	2,512	527	712	677	775	2,691	+179	+7%
売上総利益	191	238	176	193	799	157	207	217	197	777	-21	-3%
率	31.3%	32.2%	33.3%	30.5%	31.8%	29.7%	29.1%	32.0%	25.4%	28.9%	-2.9pt	-
販管費	134	142	122	136	533	134	145	154	148	581	+48	+9%
営業利益	58	96	54	58	265	23	62	63	49	196	-69	-26%
率	9.4%	13.0%	10.2%	9.1%	10.6%	4.3%	8.7%	9.2%	6.3%	7.3%	-3.3pt	-
経常利益	69	92	61	65	286	25	67	54	54	199	-87	-30%
率	11.3%	12.4%	11.5%	10.2%	11.4%	4.7%	9.4%	7.9%	6.9%	7.4%	-4.0pt	-
親会社株主に帰属する 四半期純利益	37	67	27	36	167	17	45	29	80	171	+4	+2%
率	6.1%	9.0%	5.1%	5.6%	6.6%	3.2%	6.4%	4.3%	10.3%	6.4%	-0.3pt	-

受注高・売上高実績(四半期推移)

受注高

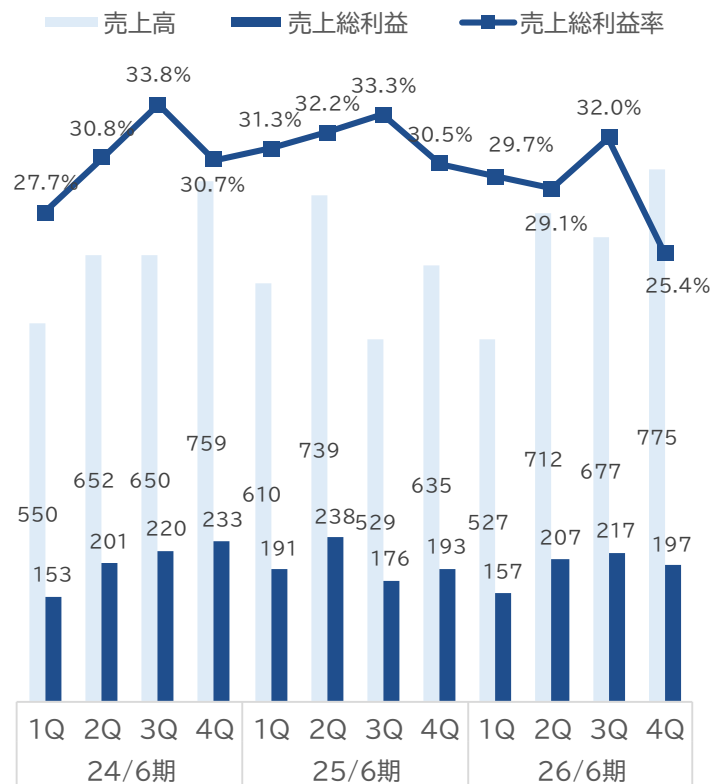


売上高

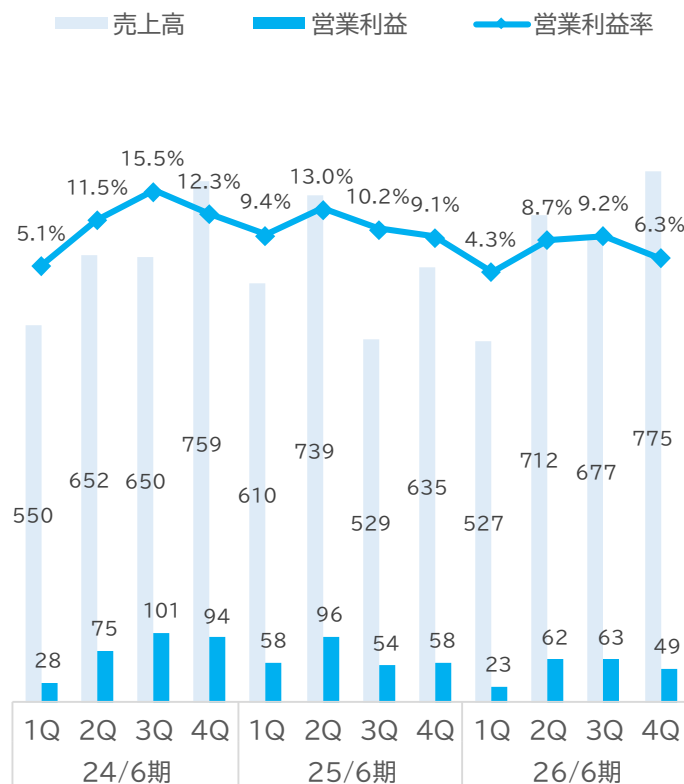


受注高・売上高実績(四半期推移)

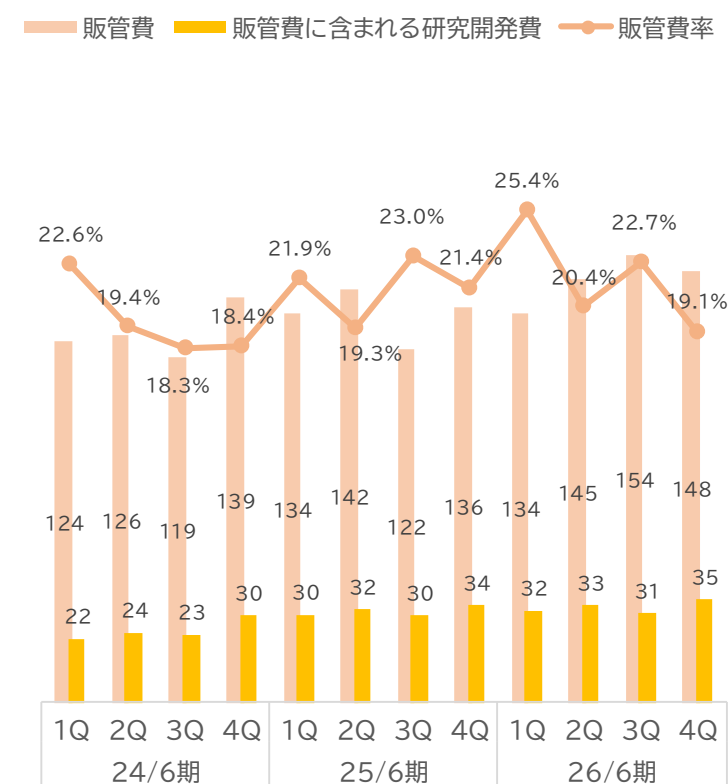
売上総利益率



営業利益率

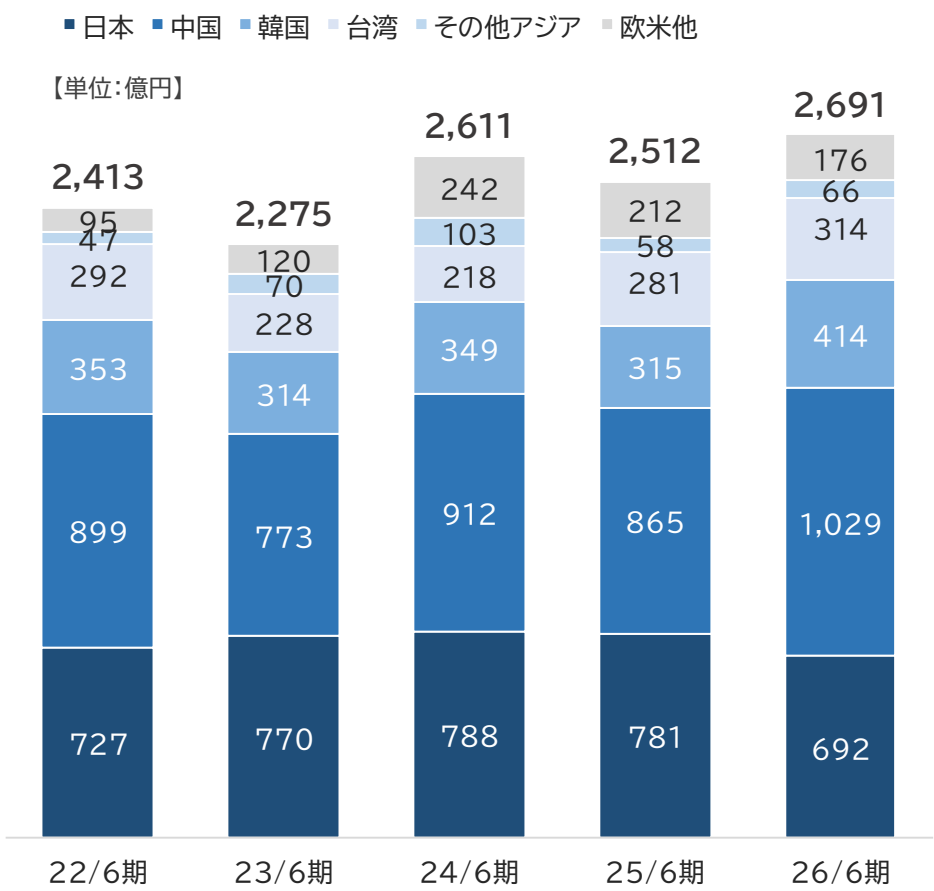


販管費率

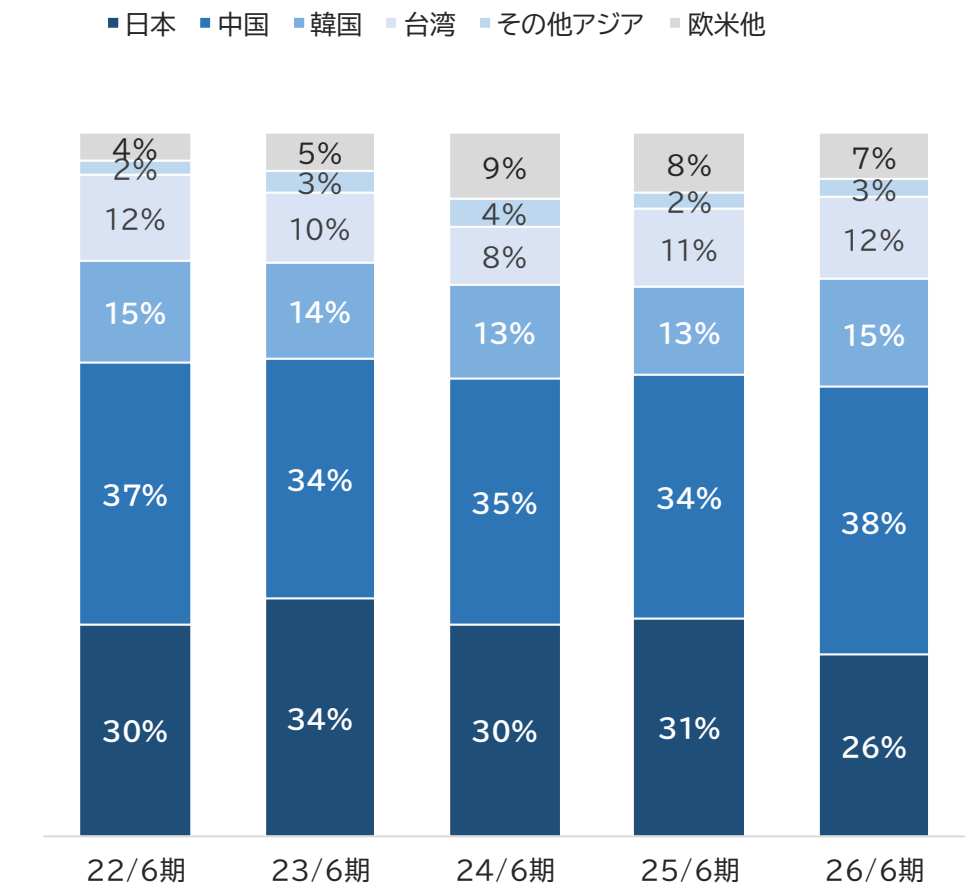


地域別売上高推移

売上高



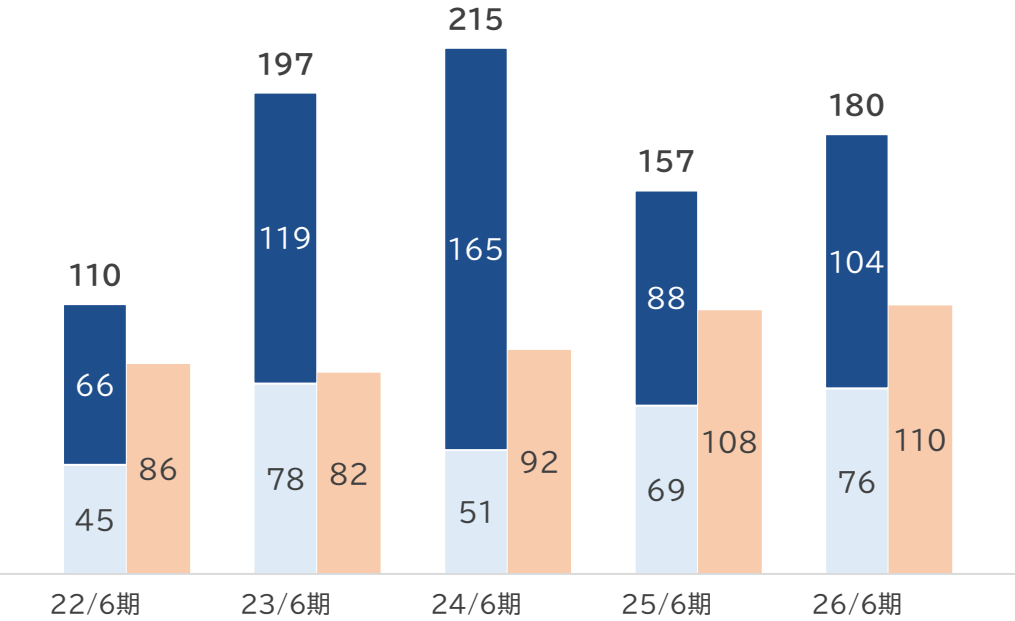
売上比率



設備投資・研究開発費推移

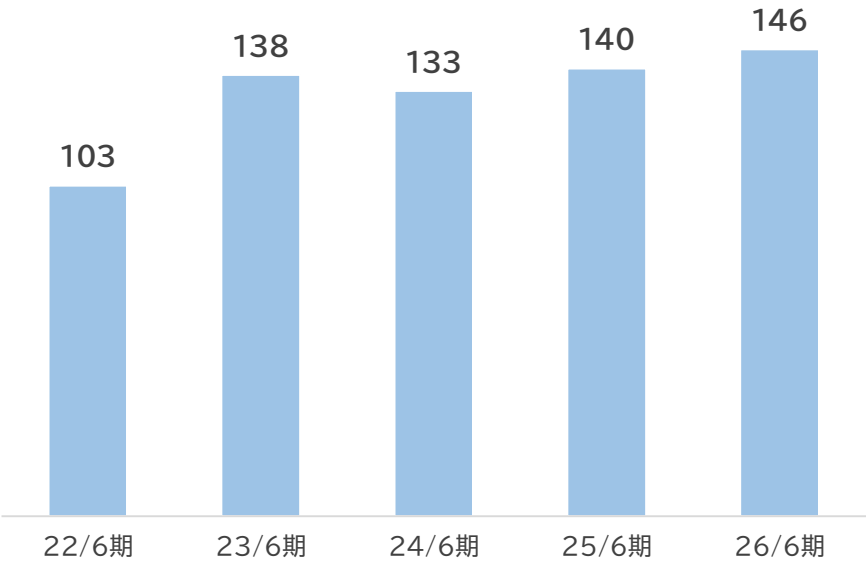
設備投資

■ 建物・生産設備等 ■ 研究開発設備 ■ 減価償却費 【単位:億円】



研究開発費*

【単位:億円】



*製造固定費及び販管費に含まれる研究開発費

品目別内訳割合(26/6期 実績・27/6期 計画)

受注高

	1Q	2Q	26/6期 3Q	4Q	通期	27/6期 通期計画
半導体電子	180億円	287億円	415億円	251億円	1,133億円	1,155億円
・ メモリ	2割弱	約2割	3割強	約4割	3割弱	3割半ば
・ ロジック	3割強	3割半ば	4割弱	数%	3割弱	2割半ば
・ 電子部品	1割半ば	2割弱	1割半ば	4割強	2割強	1割半ば
・ パワー半導体	数%	1割弱	数%	▲1割弱	数%	一桁台半ば
・ パッケージング	3割強	2割弱	1割強	2割強	約2割	約2割
ディスプレイ・エネルギー	130億円	183億円	119億円	238億円	670億円	445億円
・ LCD	4割強	3割半ば	5割弱	2割弱	3割強	5割弱
・ OLED	5割弱	6割半ば	5割強	7割弱	6割弱	5割弱
・ その他	1割強	数%	数%	1割半ば	1割弱	一桁台半ば

品目別内訳割合(26/6期 実績・27/6期 計画)

売上高

	1Q	2Q	26/6期 3Q	4Q	通期	27/6期 通期計画
半導体電子	162億円	213億円	256億円	253億円	883億円	1,070億円
・ メモリ	3割弱	2割強	2割弱	1割半ば	2割弱	2割半ば
・ ロジック	2割弱	約3割	3割弱	4割弱	3割弱	3割弱
・ 電子部品	2割強	3割弱	2割弱	3割強	2割半ば	2割半ば
・ パワー半導体	1割強	1割半ば	一桁台半ば	▲数%	一桁台半ば	数%
・ パッケージング	2割弱	一桁台半ば	3割強	約2割	約2割	2割強
ディスプレイ・エネルギー	111億円	197億円	147億円	182億円	637億円	485億円
・ LCD	3割強	4割弱	約3割	3割強	3割強	約3割
・ OLED	6割半ば	6割弱	6割半ば	7割弱	6割強	約6割
・ その他	数%	一桁台半ば	一桁台半ば	数%	一桁台半ば	約1割

品目別営業利益率順位(26/6期 4Q・通期)

半導体事業単独:3位

順位	1Q	2Q	3Q	4Q	通期
1	コンポーネント	一般産業	一般産業	一般産業	一般産業
2	一般産業	ディスプレイ・エネルギー	コンポーネント	その他	コンポーネント
3	ディスプレイ・エネルギー	コンポーネント	ディスプレイ・エネルギー	コンポーネント	その他
4	その他	半導体電子	その他	マテリアル	ディスプレイ・エネルギー
5	マテリアル	その他	半導体電子※	ディスプレイ・エネルギー	マテリアル
6	半導体電子	マテリアル	マテリアル	半導体電子※	半導体電子※

全社平均

※半導体電子・・・EV関連の一過性要因反映により収益性悪化

- **PVD (Physical Vapor Deposition : 物理成膜)**
薄膜形成をする成膜技術（当社の場合は主にスパッタ）
- **MHM (Metal Hard Mask : メタル・ハード・マスク)**
配線層形成を目的に、エッチング工程での加工用マスク膜（当社はPVD：スパッタ膜）
- **FEOL (Front End of Line)**
トランジスタやキャパシタ、抵抗などをシリコンウェハ上に形成する半導体製造プロセスの初期段階を指す
- **BEOL (Back End of Line)**
FEOLで形成されたトランジスタなどのデバイスを接続するための配線や金属層を形成する半導体製造プロセスの後半工程を指す
- **RDL (Redistribution Layer : 再配線層)**
半導体チップ上の微細な電極パッドを、より広い間隔の外部接続端子（はんだボールなど）に繋ぎ直すために形成される配線層
- **HBM (High Bandwidth Memory : 広帯域幅メモリ)**
複数のDRAMを垂直に積層し、シリコン貫通電極（TSV）で接続することで、高速・高密度を実現した次世代メモリ技術
- **WLP (Wafer Level Package : ウェーハレベルパッケージ)**
ウェーハ（半導体基板）の状態でパッケージング工程を行う技術で半導体パッケージング技術の一つ
- **PLP (Panel Level Package : パネルレベルパッケージ)**
従来のウェーハレベルパッケージ（WLP）に代わり、四角いパネル状の基板を用いてパッケージングを行う半導体パッケージング技術の一つ
パネルに多数の半導体チップを基板全体に配置して一括してパッケージングする技術
- **POR (Process of Record)**
量産に使われる認定プロセス
- **HM (Hard Mask : ハード・マスク)**
PVD等で成膜されたマスク層

**技術屋は、
世界が変わる
場所にいる。**

ULVAC